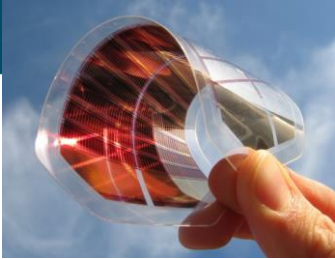


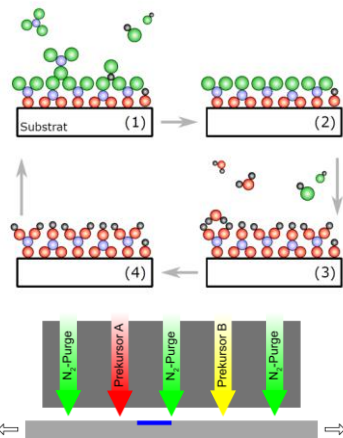
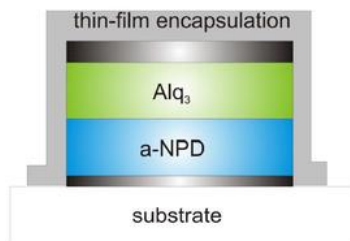


Bachelor / Master Thesis



Örtlich separierte Atomlagenabscheidung dünner Metall- und Metalloxidschichten

Durch den zunehmenden Fortschritt in der Entwicklung elektronischer Bauelemente werden auch die Anforderungen an deren Herstellungsmethoden immer größer. Flexible OLED-Displays oder biegbare organische Solarzellen benötigen beispielsweise ebenfalls eine flexible Barrierschicht, die diese Bauelemente vor äußeren Einflüssen schützt. Zudem hat die stetig fortschreitende Miniaturisierung in der Mikroelektronik zur Folge, dass immer dünnere, funktionale Dünnschichten, z.B. als Dielektrika oder als leitfähige Elektroden, benötigt werden.



Die Atomlagenabscheidung (ALD) ist ein Verfahren solche Dünnschichten im Nanometer-Bereich herzustellen. Um perspektivisch die Rolle-zu-Rolle-Prozessierung solcher Schichten zu ermöglichen, erfolgt der ALD-Prozess bei uns in einem örtlich separierten System bei Atmosphärendruck (S-ALD).

Der Lehrstuhl für Elektronische Bauelemente bietet Studierenden die Möglichkeit, ihre Bachelor- bzw. Masterthesis auf dem Gebiet der Herstellung solcher dünner Metall- oder Metalloxidschichten mittels S-ALD zu schreiben.

Ansprechpartner:

M.Sc. Tim Hasselmann

Tel.: (0202) 439-1410, E-Mail: hasselmann@uni-wuppertal.de

Gebäude: FG / Raum: 1.17